

Determinaion of the Sensitive Volume and Critical Charge for Induction of SEU in Nanometer SRAMs

Gholamreza Raisali¹ , Masume Soleimaninia^{2*}  and Amir Moslehi³

1. Professor, Nuclear Sciences and Technology Research Institute, Atomic Energy Organization of Iran, Tehran, Iran

2. Ph.D., Nuclear Sciences and Technology Research Institute, Atomic Energy Organization of Iran, Tehran, Iran

3. Assistant Professor, Nuclear Sciences and Technology Research Institute, Atomic Energy Organization of Iran, Tehran, Iran

*Corresponding Author's E-mail: msoleimaninia@aeoi.org.ir

Abstract

In this paper, the sensitive volume and critical charge ($Q_{critical}$) of a 65-nm CMOS SRAM in induction of Single-Event-Upset (SEU) have been determined. To this purpose, a memory cell consisting of NMOS and PMOS was simulated using Silvaco TCAD tool and variations in output voltages were studied after striking incident beam with different values of LET. The $Q_{critical}$ was calculated by integrating the output current when the output voltages were inverted. To determine the sensitive volume, the minimum amount of LET in which the output logic state of the memory cell flips, was considered as a criterion of sensitivity. The results showed that the value of $0.054 \mu\text{m}^3$ for sensitive volume and 1.48 fC for $Q_{critical}$ which are in good agreement with other references.

Keywords: Sensitive Volume, Critical Charge, nanometer SRAM, Linear Energy Transfer (LET), Single Event Upset (SEU), Silvaco TCAD

1. Introduction

Nowadays, microelectronic devices are widely used in environments with high levels of ionizing radiation such as space. Rapid downscaling of these devices into sub-micron technologies, made them become more sensitive to radiation. When the electronic devices are exposed to radiation, they may lose their correct operation.

Single Event Upset (SEU) as the most common event in new nanometer technologies refers to the phenomenon in which a single particle causes abrupt changes in the logic state of some microelectronic devices such as memory. Sensitive volume and critical charge ($Q_{critical}$) are two key quantities which are required for SEU cross-section calculations. A widely used microelectronic device that is prone to SEU is SRAMs. The most common type of SRAMs used in commercial applications is consisting of 6 MOSFETs (3 NMOS & 3 PMOS) which is studied in this work.

2. Methodology

In this paper, to determine the sensitive volume and critical charge, one of the SRAM cells is simulated using Mixed-Mode and Victory modules of Silvaco

TCAD tool. In this approach, the struck transistor is modeled in 3D and the others are modeled using SPICE. In this work, a 3D model was proposed based on 65-nm technology for struck NMOS transistor [1]. To ensure the accuracy of the model, the characteristic curve of I_d - V_g extracted. When an incident particle passes through a semiconductor material, electron-hole pairs release along its path. The mean amount of energy loss per unit distance by the impinging particle is called LET. To determine the sensitive volume, the incident particle beam has been struck in different regions of NMOS and PMOS and the variations in output voltages have been considered. The minimum LET in which the output voltages flip, has been considered as a criterion for sensitivity. In order to determine the critical charge, the incident particle beam with different values of LET was irradiated to the NMOS as the most sensitive transistor and the output voltage variations were considered. The results have been discussed in the next section.

3. Results and Discussion

Figure 1, illustrates the output voltages of the cell. As can be observed, there is a minimum LET in which the logic state of



COPYRIGHTS

© 2023 by the authors. Published by Aerospace Research Institute. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of [the Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

How to cite this article:

G.R. Raisali, M. Soleimaninia and A. Moslehi, "Determination of the Sensitive Volume and Critical Charge for Induction of SEU in Nanometer SRAMs," *Journal of Space Science and Technology*, Vol. 16, No. 2, pp. 43-54, 2023 (in Persian), <https://doi.org/10.30699/jsst.2023.1423>.

the output changes. Figures 2, 3, 4 show minimum LET triggering SEU for incident beam in different positions in NMOS and PMOS. It clearly shows that there are regions in which flipping the output voltages require lower LET. These regions are more sensitive than the others. Calculations show the $0.054 \mu\text{m}^3$ for SRAM sensitive volume.

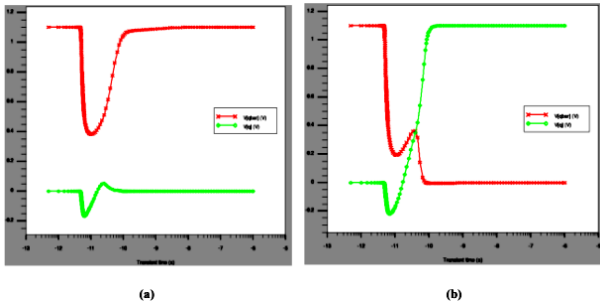


Figure 1. Variations in output voltages in $V_{DD}=1.1$ V for (a) $LET=1 \text{ MeV}\cdot\text{cm}^2/\text{mg}$, (b) $LET=1.2 \text{ MeV}\cdot\text{cm}^2/\text{mg}$.

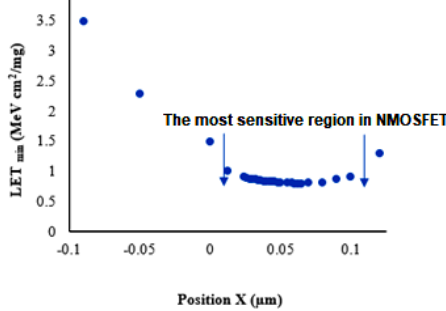


Figure 2. The most sensitive region along X-axis in NMOS.

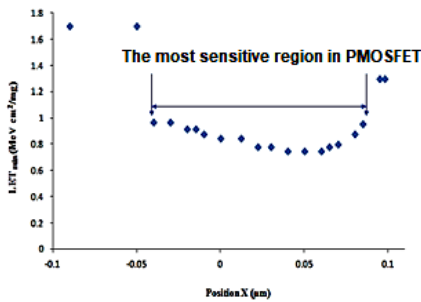


Figure 3. The most sensitive region along X-axis in PMOS.

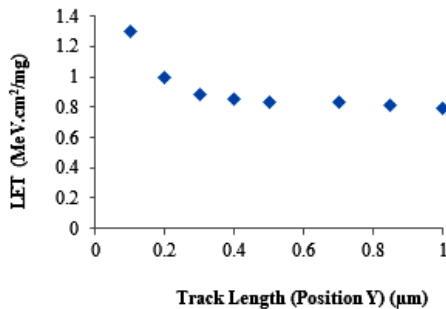


Figure 4. Sensitivity for different track lengths of incident particle along Y-axis in NMOS & PMOS.

The output current (I_d) has been shown in Figure 5. The critical charge is calculated by integrating the output current over the time interval that the logic state of output voltage changes. According to Figure 5, critical charge is the specified area under the curve. Calculation of the specified area under the curve resulted in 1.48 fC for critical charge. The most sensitive volume of the similar SRAM in the work of Bing et al. [2] has been obtained to be $0.05 \mu\text{m}^3$. Also, they reported 1.35 fC for the critical charge. Clearly, there is a reasonable agreement between our simulations using Silvaco and their experiment research.

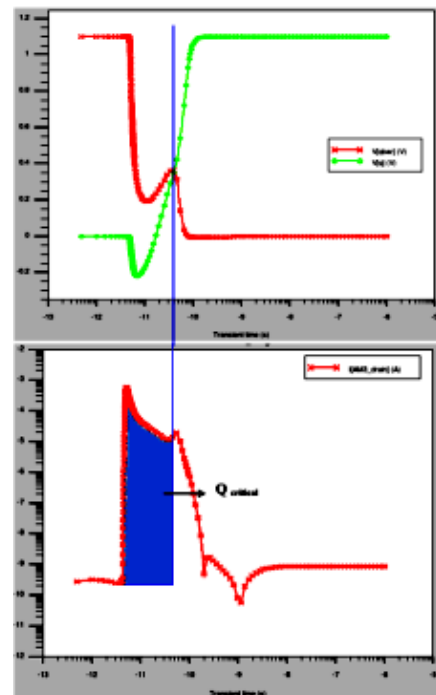


Figure 5. calculation of critical charge when the logic state of output inverted.

4. Conclusion

SEUs are the major threat to system reliability in today's nanometer technologies. In this paper, using Silvaco TCAD tool, a simulation work has been conducted to define the sensitive volume and critical charge in a 65-nm CMOS SRAM. Our simulation results are consistent with those obtained with the experiments reported in other studies.

5. References

- [1] Semiconductor Industry Association (SIA), "International technology roadmap for semiconductors," [Online] <http://www.itrs.net>, 2012.
- [2] Ye. Bing, J. Liu, T.S. Wang, T.Q. Liu, J. Luo, B. Wang, Y.N. Yin, "Impact of energy straggle on proton-induced single event upset test in a 65-nm SRAM cell." Chinese Physics B 26, no. 8: 088501, 2017.

تعیین حجم حساس و بار بحرانی برای وقوع رخداد SEU در حافظه‌های نانومتری SRAM

غلامرضا رئیس‌علی^۱ ID، معصومه سلیمانی‌نیا^{۲*} ID و امیر مصلحی^۳
پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران

*ایمیل نویسنده مخاطب: msoleimaninia@aeoi.org.ir

چکیده

در این پژوهش، حجم حساس و بار بحرانی یک حافظه SRAM با فناوری ۶۵ نانومتری CMOS، به‌عنوان دو کمیت مهم در محاسبات ترابرد پرتو در رخداد به‌هم‌ریختگی تک‌حادثه‌ای (SEU) که رایج‌ترین رخداد از منظر آسیب پرتویی و تشعشعات فضایی محسوب می‌شود، تعیین شد. بدین منظور، ابتدا یک سلول حافظه متشکل از ترانزیستورهای NMOS و PMOS با استفاده از نرم‌افزار Silvaco TCAD شبیه‌سازی شد. برای تعیین دو کمیت مذکور، پرتو با مقادیر مختلف از انتقال خطی انرژی (LET) به نواحی گوناگون ترانزیستورها تابانده شد و ولتاژ خروجی مورد بررسی قرار گرفت. بار بحرانی به‌عنوان کمترین بار لازم برای تغییر وضعیت منطقی سلول، با انتگرال‌گیری از جریان درین در لحظه تغییر وضعیت ولتاژ خروجی حاصل شد. برای تعیین حجم حساس نیز کمینه LET که در هر نقطه منجر به تغییر در وضعیت منطقی خروجی‌ها می‌شود، معیاری از حساسیت در نظر گرفته شد. نتایج ضمن تطابق با مراجع، مقادیر حجم حساس و بار بحرانی را به ترتیب 0.54 و $1/48 fC$ نشان دادند.

واژه‌های کلیدی: حجم حساس، بار بحرانی، حافظه نانومتری SRAM، انتقال خطی انرژی، SEU، Silvaco TCAD

اختصارات

International Technology Roadmaps for Semiconductors (ITRS)	نقشه راه فناوری بین‌المللی برای نیمه‌هادی‌ها	Single Event Effect (SEE)	اثرات تک‌حادثه‌ای
Single Event Burnout (SEB)	رخداد تک‌حادثه‌ای سوختن	Single Event Upset (SEU)	به‌هم‌ریختگی‌های تک‌حادثه‌ای
Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT)	ترانزیستور دوقطبی با گیت عایق شده	Total Ionizing Dose (TID)	دوز یونیزان کل
Single Event Gate Rupture (SEGR)	رخداد تک‌حادثه‌ای از هم‌گسیختگی گیت	Displacement Damage (DD)	آسیب جابه‌جایی
Gallium-Nitride (GaN) Transistor	ترانزیستور گالیم-نیتريد	Linear Energy Transfer (LET)	انتقال خطی انرژی
Technology-Computer-Aided-Design (TCAD)	طراحی فناوری به کمک رایانه	Critical Charge ($Q_{critical}$)	بار بحرانی

مقدمه

این پژوهش به بررسی چگونگی محاسبه دو کمیت اصلی گفته شده در تعیین این دسته از رخدادها (حجم حساس و بار بحرانی) پرداخته شود.

شایان ذکر است که به دلیل پیچیدگی محاسبات و عدم دسترسی به اطلاعات اولیه لازم برای شبیه سازی، تعیین حجم حساس و بار بحرانی عمدتاً با استفاده از روش های تجربی صورت می گیرد. از جمله پژوهش های محدود در زمینه تعیین حجم حساس به کمک شبیه سازی، تحقیقاتی است که توسط Zerarka انجام شده است. در سال های ۲۰۱۱، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷، Zerarka و همکارانش با استفاده از نرم افزار Sentarus TCAD به محاسبه حجم حساس در رخداد های SEB و SEGR در ترانزیستورهای IGBT و GaN پرداختند [۸-۶]. در مورد محاسبه بار بحرانی انجمن الکترونیک فضایی، استفاده از نرم افزارهای TCAD را برای توصیف دقیق تر در تخمین میزان به هم ریختگی های تک حادثه ای پیشنهاد داده است [۹]. با این وجود، برخی محققان با برشمردن فرضیاتی، از نرم افزارهایی همچون SPICE برای تخمین بار بحرانی بهره جسته اند [۱۰-۱۱]. نتایج پژوهش Naseer و همکاران نشان می دهد که مقادیر بار بحرانی محاسبه شده به کمک شبیه سازی های سه بعدی، ممکن است تا ۳ برابر کمتر از مقادیر به دست آمده به کمک سایر شبیه سازها به دست آید [۹]. با توجه به اینکه این کمیت، مبنای پیش بینی و تخمین SEU است، میزان به هم ریختگی ها به کمک شبیه سازهای غیر سه بعدی، به نحو قابل ملاحظه ای کمتر از مقدار واقعی پیش بینی می شود.

با توجه به تنوع فناوری های مختلف قطعات نیمه هادی، حوزه های تحقیقاتی زیادی در این زمینه وجود دارد. در این پژوهش، برای نخستین بار، تحلیل جامعی از محاسبه حجم حساس و بار بحرانی به عنوان دو کمیت اصلی در تعیین رخداد به هم ریختگی تک حادثه ای (SEU) در فناوری ۶۵ نانومتری انجام گرفته است. جامعیت محاسبات انجام شده، از آن جهت است که تعیین دو کمیت مذکور بر مبنای مدل کالیبره شده ترانزیستورهای NMOS و PMOS با توجه به فناوری مذکور بوده است. در این پژوهش، کلیه فرایندهای شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Silvaco TCAD انجام شده است تا توانمندی آن جهت انجام اینگونه محاسبات، سنجیده شود. پژوهش هایی که به آن ها اشاره شد، عمدتاً با استفاده از نرم افزار Sentaurus TCAD انجام شده اند.

با توجه به توضیحات فوق، در این پژوهش به منظور تعیین دو کمیت حجم حساس و بار بحرانی، به شبیه سازی فرایند ساخت و عملکرد اجزای سازنده یک سلول از حافظه SRAM با فناوری ۶۵ نانومتر با استفاده از نرم افزار Silvaco TACD پرداخته شد و مدلی

امروزه، توسعه صنعت میکروالکترونیک نقش مهمی در صنعتی شدن کشورها ایفا می کند. با به کارگیری فناوری های زیرمیکرونی کنونی، ابعاد مدارهای مجتمع کاهش یافته و توان و سرعت سیستم به طور چشمگیری افزایش می یابد. اما کاهش ابعاد قطعات، پیامد افزایش حساسیت آن ها در برابر پرتوها را به دنبال دارد [۱]. از قطعات میکروالکترونیک، به وفور در صنعت هوافضا استفاده می شود. متأسفانه محدودیت هایی پیرامون عملکرد و طول عمر ماهواره ها و سفینه های فضایی وجود دارد که عمدتاً مربوط به اثرات پرتو بر قطعات میکروالکترونیک به کار گرفته شده درون آن هاست.

به طور کلی، قرارگیری قطعات میکروالکترونیک در معرض انواع مختلف پرتو در کاربردهای فضایی می تواند موجب آسیب و بروز اختلال در عملکرد آن ها شود. اثرات تک حادثه ای، از مهم ترین اثرات پرتو بر قطعات الکترونیک با فناوری های کنونی هستند که دسته بندی های متعددی دارند و رایج ترین آن ها رخداد به هم ریختگی های تک حادثه ای (SEU) می باشند [۲]. این رخداد که حافظه های الکترونیکی و لچ ها را متأثر می سازد، زمانی روی می دهد که وضعیت منطقی یک سلول در نتیجه بارهای ایجاد شده از پرتو فرودی تغییر کند.

حافظه های SRAM، از جمله حساس ترین قطعات الکترونیک در برابر پرتو محسوب می شوند. از آنجاکه این حافظه ها مساحت نسبتاً بزرگی از سطح تراشه را در ریزپردازنده های کنونی اشغال کرده و بار بحرانی در آن ها نسبتاً اندک است، گزینه مناسبی جهت تحقیق پیرامون رخداد به هم ریختگی تک حادثه ای محسوب می شوند [۳].

دو کمیت کلیدی در تبیین رخداد به هم ریختگی تک حادثه ای، بار بحرانی و حجم حساس است [۴]. حجم حساس قطعه، حجمی است که کلیه بارهای برجا گذاشته شده توسط ذرات اولیه و ثانویه مؤثر بر رخداد را شامل می شود. بار بحرانی نیز کمترین مقدار بار ایجاد شده درون حجم حساس برای وقوع یک رخداد است. کاهش ابعاد در فناوری های جدید، به کاهش بار بحرانی مورد نیاز برای ایجاد به هم ریختگی در قطعات میکروالکترونیک منجر شده و آن ها را نسبت به رخداد SEU آسیب پذیرتر ساخته است [۵]. به این جهت، در بیشتر کشورهای دنیا پیش از به کارگیری قطعات الکترونیک در مأموریت های فضایی، از آزمون های تجربی جهت تخمین حساسیت آن ها در برابر رخداد SEU استفاده می شود. در کشور ما، به دلیل نبود زیرساخت های لازم جهت انجام آزمون های تجربی SEU، تنها گزینه ممکن، محاسبات و شبیه سازی است. اهمیت روزافزون تحقیقات پیرامون این حوزه در دنیا طی سال های اخیر و وجود خلأ در فعالیت های انجام گرفته در این زمینه در کشور، سبب شد تا در

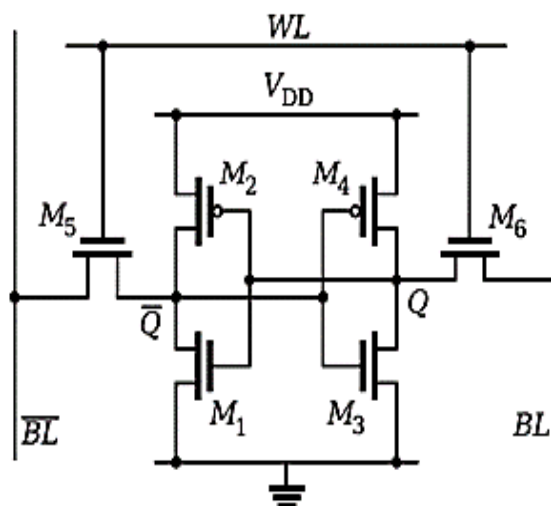
آمده، منحنی‌های مشخصه I_d-V_g و I_d-V_d قطعه استخراج و با منحنی‌های موجود در مراجع انطباق داده شدند که به این فرایند کالیبراسیون گفته می‌شود. معیار کالیبراسیون، کمترین مقدار خطا نسبت به داده‌های مرجع با روش جذر میانگین مربعات در نظر گرفته شد. برای دستیابی به مدل سه بعدی قطعه، مجهولات زیادی پیرامون ابعاد و میزان دوپینگ نواحی سازنده وجود دارد [۱۳]. فلوچارت کار انجام شده در این پژوهش، در شکل ۲ نشان داده شده است.

در این پژوهش، شبیه‌سازی فرایند ساخت ترانزیستور NMOS با در نظر گرفتن زیرلایه‌ای با ابعاد $0.325 \times 0.2 \times 1 \mu m^3$ از جنس سیلیکون با آلاینده بور آغاز شد و در دو راستای محور آن مش‌بندی به صورت غیریکنواخت انجام گرفت. سپس، لایه‌ای از جنس دی‌اکسید سیلیکون بر روی زیرلایه سیلیکونی نشانده شد و پس از آن، پلی‌سیلیکون به عنوان ماده سازنده گیت بر روی لایه اکسید لایه‌نشانی شد. در گام بعد، به منظور ایجاد نواحی سورس و درین در دو سمت گیت ماده پلی‌سیلیکون خورده شد و در آن‌ها یون‌های آرسنیک به عنوان ناخالصی دهنده کاشته شدند. به منظور جلوگیری از اتصال الکتریکی گیت با سورس و درین، نیتريد سیلیکون لایه‌نشانی شد [۱۴]. برای الکترودهای سورس و گیت و درین نیز آلومینیوم در نواحی مربوطه قرار گرفت. شایان ذکر است کلیه فرایندهای گفته شده با تغییر پارامترهای مختلف در شبیه‌سازی‌ها انجام شد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها در جدول (۱) آورده شده است. طرح نهایی ترانزیستور ۶۵ نانومتر NMOS با استفاده از شبیه‌ساز Victory به همراه مش‌بندی نواحی مختلف در شکل (۳) نشان داده شده است.

جدول ۱- پارامترهای مهم در شبیه‌سازی NMOS

پارامتر	مقدار
طول گیت	۶۵ nm
ضخامت اکسید گیت	۱/۸ nm
انرژی یون آرسنیک کاشته شده در ناحیه سورس-درین	۵ keV
مقدار یون آرسنیک کاشته شده در ناحیه سورس-درین	$4/5 \times 10^{13} \text{ atom/cm}^2$
مقدار دوپینگ زیرلایه	$1/3 \times 10^{14} \text{ atom/cm}^2$

سه بعدی پس از در نظر گرفتن حالت‌ها و شرایط مختلف برای اجزای سازنده آن پیشنهاد گردید. سپس، بر مبنای مدل به دست آمده کمیت‌های بار بحرانی و حجم حساس محاسبه و با مقادیر گزارش شده در مراجع مقایسه شدند. طرحواره‌ای از یک سلول سازنده حافظه SRAM در شکل (۱) نشان داده شده است.

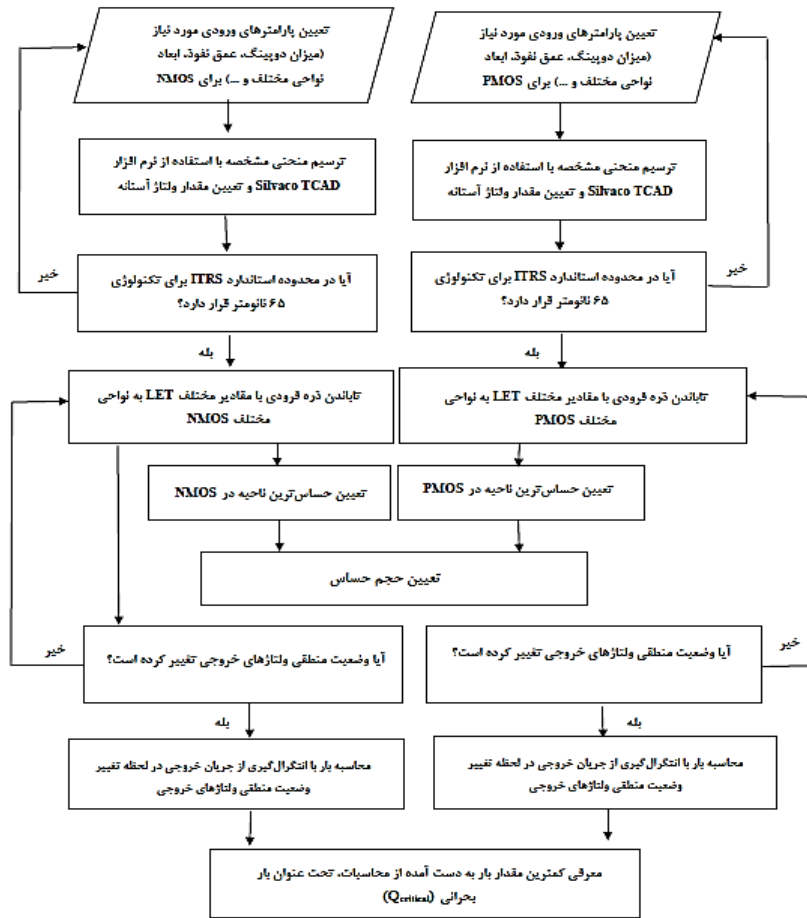


شکل ۱- طرحواره‌ای از یک سلول سازنده حافظه SRAM.

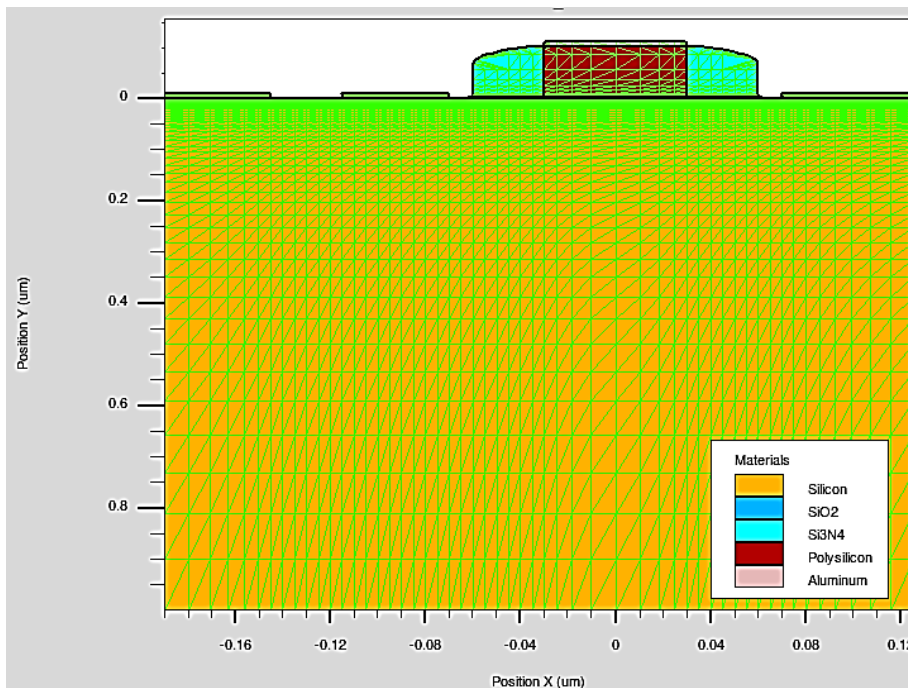
نرم‌افزار Silvaco ابزار سریع و دقیقی برای انواع شبیه‌سازی‌ها در فناوری‌های جدید قطعات نیمه‌هادی به‌شمار می‌رود. این نرم‌افزار با توجه به اطلاعات ساختار قطعه و مدل‌های فیزیکی، معادلات دیفرانسیل پایه مانند پواسون، پیوستگی و ترابرد را بر پایه روش المان محدود درون قطعه نیمه‌هادی حل می‌کند [۱۲]. این نرم‌افزار، متشکل از شبیه‌سازهای متعدد است که از میان آن‌ها، شبیه‌ساز Victory ابزار قدرتمندی برای شبیه‌سازی‌های سه بعدی در حوزه فناوری‌های پیشرفته کنونی محسوب می‌شود. این شبیه‌ساز، با بهره‌گیری از دو ماژول Victory Process و Victory device امکانات جامعی را برای شبیه‌سازی قطعات الکترونیک در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

روش کار

چنانچه اشاره شد، به منظور تعیین بار بحرانی و حجم حساس در گام نخست، یک سلول حافظه SRAM با استفاده از نرم‌افزار Silvaco TACD شبیه‌سازی شد و پس از در نظر گرفتن حالت‌ها و شرایط مختلف، مدلی سه بعدی برای ترانزیستورهای NMOS و PMOS سازنده آن پیشنهاد گردید. جهت اطمینان از صحت مدل به‌دست



شکل ۲- فلوجارت کار انجام شده در این پژوهش.



شکل ۳- الگویی از مش‌بندی نواحی مختلف در ساختار NMOS طراحی شده با فناوری ۶۵ نانومتری.

(۵) نشان داده شده است. مقایسه دو منحنی به دست آمده از کالیبراسیون PMOS در این پژوهش و تحقیق Kumar و همکارانش در مرجع [۱۶] در شکل ۶ نشان داده شده است. این منحنی به ازای طول گیت ۶۵ نانومتر و ضخامت اکسید گیت ۲/۳ نانومتر به دست آمد که در آن بایاس گیت از ۰ V تا ۲ V - متغیر است. با توجه به منحنی شکل ۶ برای مدل به دست آمده کنونی، ولتاژ آستانه برابر با ۰/۲۱ V - به دست آمد که در محدوده استاندارد ITRS قرار دارد [۱۵].

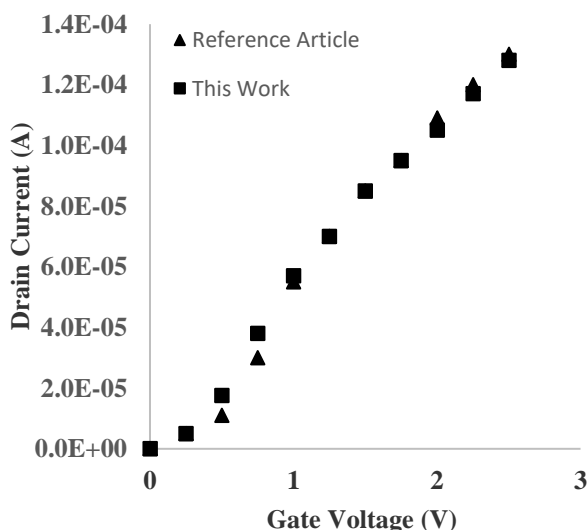
جدول ۲- پارامترهای مهم در شبیه سازی PMOS

پارامتر	مقدار
طول گیت	۶۵ nm
ضخامت اکسید گیت	۲/۳ nm
انرژی یون پور کاشته شده در ناحیه سورس- درین	۵ keV
مقدار یون پور کاشته شده در ناحیه سورس- درین	$۱/۸ \times ۱۰^{۱۴}$ atom/cm ²
مقدار دوپینگ زیرلایه	۲×۱۰^{۱۵} atom/cm ²

چنانچه اشاره شد، دو مفهوم اساسی در تبیین رخداد به هم ریختگی تک حادثه ای، بار بحرانی و حجم حساس است. تحقیقات نشان داده که حساس ترین ترانزیستورها در برابر پرتو ترانزیستورهای خاموش هستند [۱۷]. از آنجا که هر سلول SRAM متشکل از دو معکوس کننده است، در هر سلول دو ناحیه حساس به پرتو وجود دارد که یکی مربوط به NMOS و دیگری مربوط به PMOS خاموش می باشد. هدف از محاسبات پیش رو، تعیین حجمی از سلول SRAM (موسوم به حجم حساس) است که در نتیجه برخورد پرتو به آن حالت منطقی در ولتاژ خروجی تغییر می یابد. برای تعیین حجم حساس در حافظه SRAM با فناوری ۶۵ نانومتری CMOS، یک سلول از آن با استفاده از شبیه سازی های Mixed-Mode و Victory نرم افزار Silvaco شبیه سازی شد. در رهیافت به کار گرفته شده که به طور شماتیک در شکل (۷) نشان داده شده است، ابتدا با استفاده از شبیه ساز Victory مدل سه بعدی برای ترانزیستوری که پرتو به آن برخورد کرده در نظر گرفته شد و به منظور کاهش زمان اجرای شبیه سازی ها، سایر اجزا به کمک شبیه ساز Mixed-Mode به صورت المان های مداری شبیه سازی شدند [۱۸].

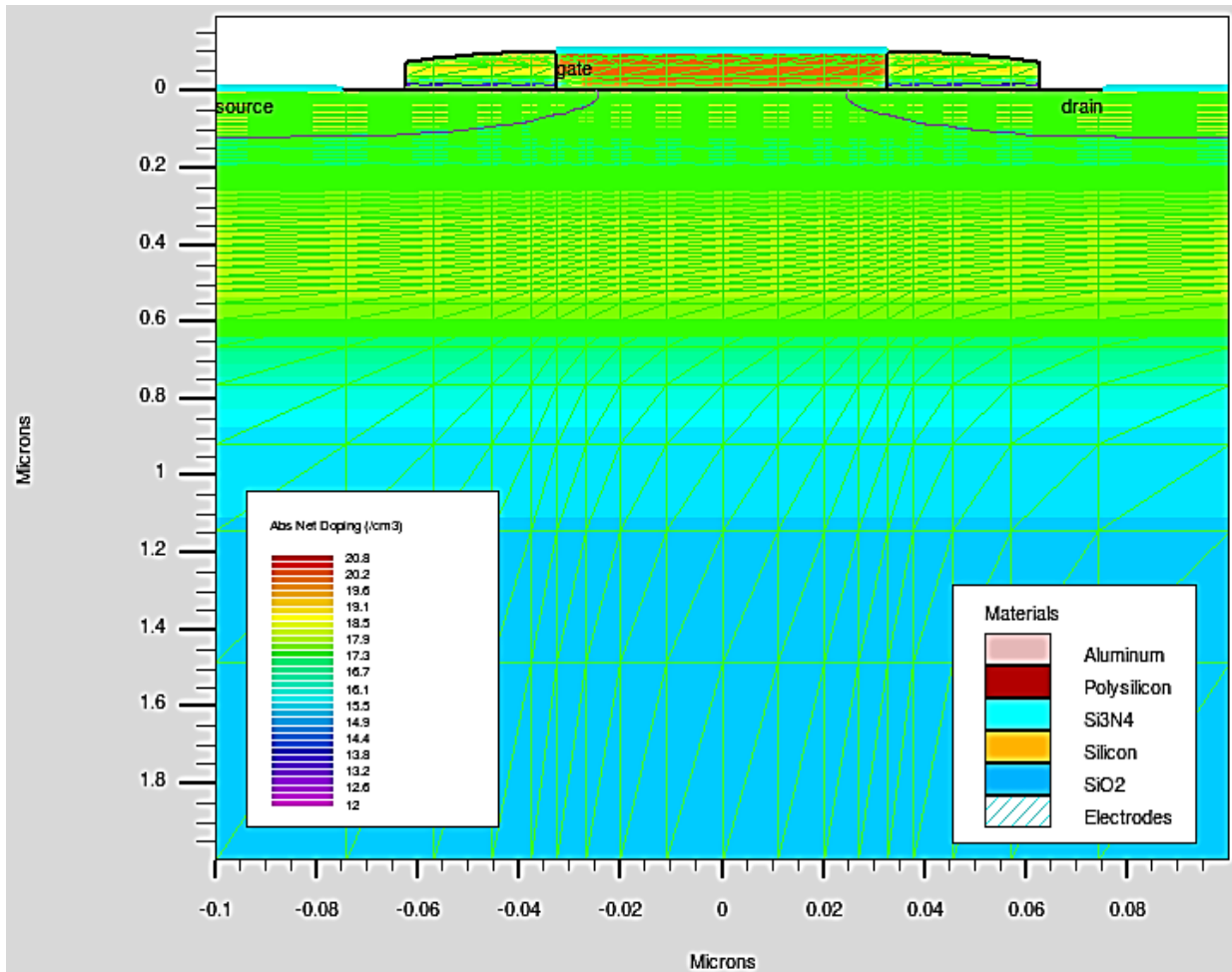
شکل (۴)، مقایسه ای از داده های به دست آمده در این پژوهش برای منحنی مشخصه I_d-V_g ترانزیستور NMOS طراحی شده با نتایج به دست آمده از پژوهش Kumar و همکارانش در مرجع [۱۴] را نشان می دهد که در آن، بایاس درین مقدار ثابت ۰/۱ V و بایاس گیت از ۰ تا ۲/۵ V متغیر است.

بررسی مقالات موجود نشان می دهد، مهم ترین پارامتر خروجی در کالیبراسیون قطعه، ولتاژ آستانه است [۱۴]. مطابق با الگوی ارائه شده توسط نقشه راه ITRS، ولتاژ آستانه برای فناوری ۶۵ نانومتر باید در محدوده ۰/۱۷۶ V تا ۰/۲۲۵ V باشد [۱۵]. در این پژوهش، ولتاژ آستانه ۰/۱۸۳ V به دست آمد که در محدوده مذکور واقع است.



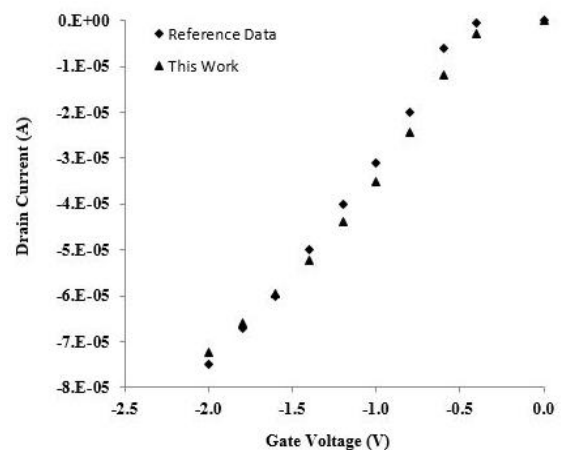
شکل ۴- مقایسه منحنی مشخصه I_d-V_g به دست آمده از این پژوهش با داده های استخراج شده از مرجع [۱۴].

پس از گام فوق، به کالیبراسیون PMOS با فناوری ۶۵ نانومتر به کمک شبیه ساز Victory پرداخته شد. در این بخش نیز شبیه سازی با در نظر گرفتن زیرلایه سیلیکونی با ابعاد $۱ \times ۲ \times ۰/۲ \mu m^3$ و با آلاینده فسفر به عنوان ناخالصی آغاز شد و در راستای محورها مش بندی هایی به صورت غیریکنواخت انجام گرفت. سپس، دی اکسید سیلیکون بر روی زیرلایه سیلیکونی لایه نشانی و پلی سیلیکون به عنوان ماده سازنده گیت بر روی آن نشانیده شد. پس از آن، به منظور ایجاد نواحی سورس و درین در دو سمت گیت ماده پلی سیلیکون خورده شد و در آن ناحیه یون های پور به عنوان ناخالصی پذیرنده کاشته شدند. طراحی PMOS نیز با تغییر پارامترهای متعددی انجام شد که برخی از مهم ترین آن ها در جدول (۲) آورده شده است. ساختار نهایی ترانزیستور PMOS با فناوری ۶۵ نانومتر به همراه مش بندی در نواحی مختلف در شکل



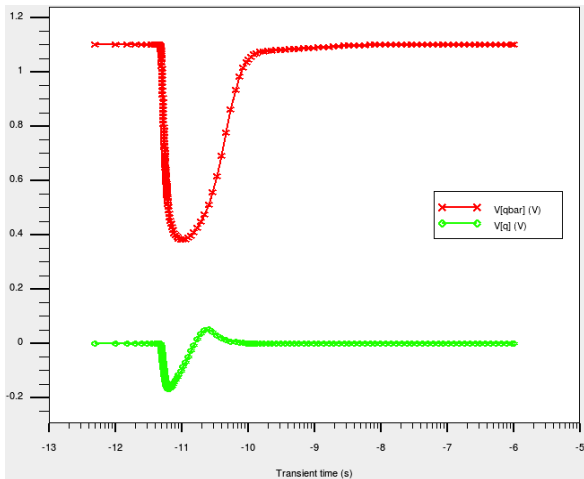
شکل ۵- الگویی از مش بندی نواحی مختلف در ساختار PMOS طراحی شده با فناوری ۶۵ نانومتری

مقدار زیادی الکترون- حفره در امتداد طول مسیر خود ایجاد می کنند. مقدار میانگین انرژی از دست داده شده ذره بر واحد طول مسیر با مفهوم انتقال انرژی خطی بیان شده و از آن تحت عنوان LET یاد می شود [۱۹]. این کمیت معمولاً به چگالی ماده هدف بهنجار شده و بر حسب $\text{MeV.cm}^2/\text{mg}$ بیان می شود. این کمیت در نرم افزار Silvaco TCAD نیز بر حسب $\text{MeV.cm}^2/\text{mg}$ و با عبارت دستوری LET بیان شده است. در سیلیکون که ماده غالب مورد استفاده در ادوات نیمه هادی است، تقریباً $3/6 \text{ eV}$ انرژی صرف ایجاد یک جفت الکترون- حفره می شود [۱۹]. به منظور تعیین حجم حساس به هنگام وقوع رخداد به هم ریختگی تک حادثه ای، پرتو فرودی با مقادیر متفاوتی از LET همانند شکل (۸)، به نواحی مختلف ترانزیستورهای NMOS و PMOS تابانده شد و هر بار تغییرات ولتاژ در دو نقطه Q و \bar{Q} (خروجی معکوس کننده ها در شکل (۱) مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن ها در شکل (۹) نشان داده شده است.

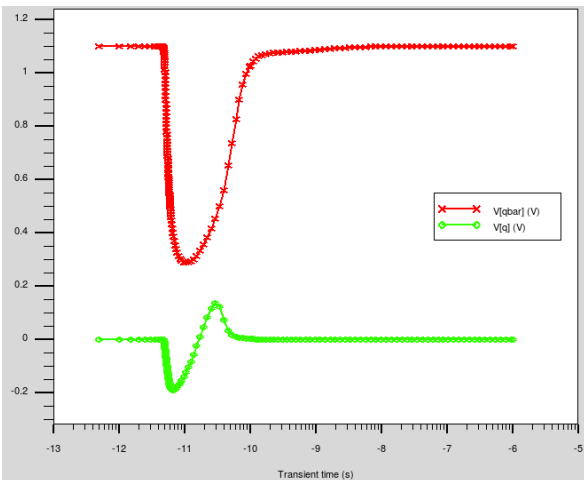


شکل ۶- مقایسه منحنی مشخصه I_d-V_g ترانزیستور PMOS طراحی شده در این پژوهش با داده های استخراج شده از مرجع [۱۶]

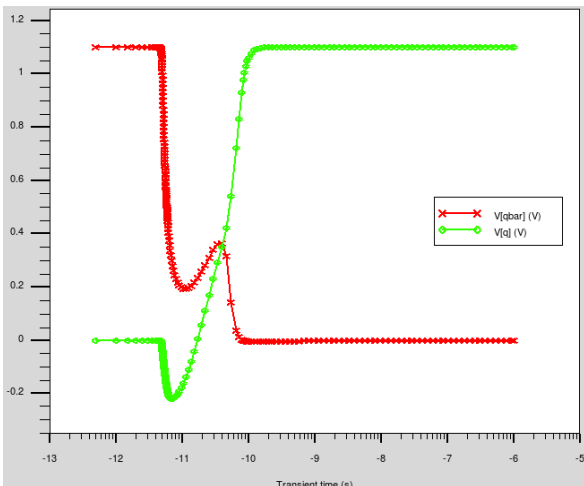
وقتی پرتو به قطعه نیمه هادی برخورد می کند، بخشی از انرژی خود را طی مکانیزم های یونش و یا برانگیزش اتمها از دست داده و



(a)

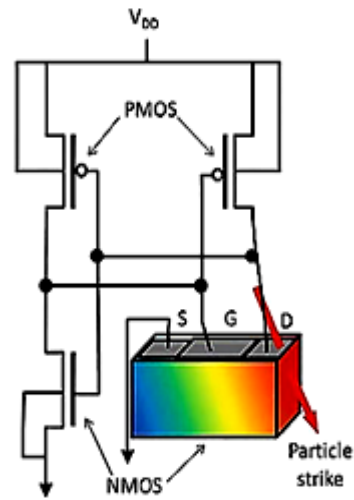


(b)

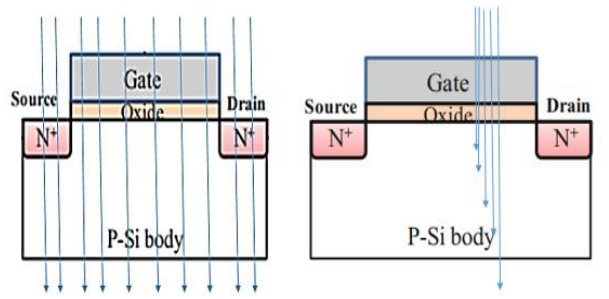


(c)

شکل ۹- چگونگی تغییر در خروجی های Q و Q̄ در بایاس ثابت ۱/۱ V به ازای (a) LET=1.1 MeV.cm2/mg (b) LET=1 MeV.cm2/mg و (c) LET=1.2 MeV.cm2/mg



شکل ۷- شماتیکی از رهیافت به کار گرفته شده در شبیه سازی سلول حافظه با استفاده از شبیه سازی های Mixed-Mode و Victory [۱۸].



شکل ۸- برخورد پرتو فرودی به نقاط مختلف ترانزیستورهای NMOS و جهت یافتن حساس ترین نواحی به پرتو.

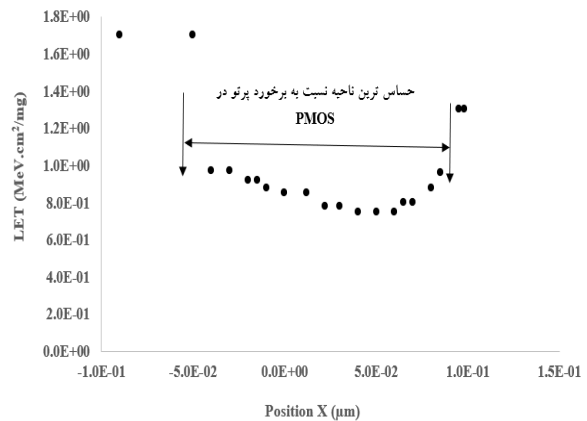
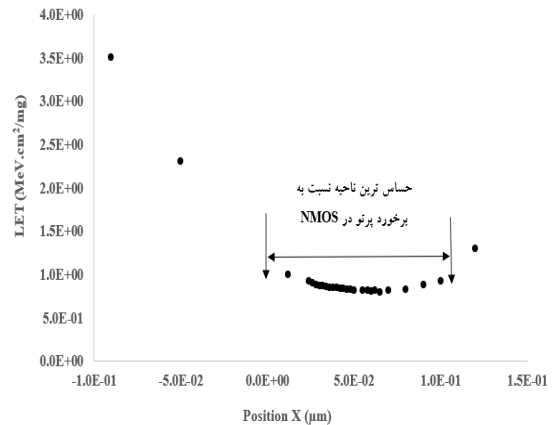
شکل ۹، خروجی معکوس کننده ها را به ازای سه مقدار LET هنگام برخورد پرتو به یک نقطه از درین ترانزیستور در ولتاژ $V_{ds}=1.1V$ نشان می دهد. منحنی های قرمز و سبز رنگ، ولتاژهای خروجی در دو نقطه Q و Q̄ هستند که چگونگی تغییر آن ها در نتیجه برخورد پرتو فرودی به ازای مقادیر مختلف LET نشان داده شده است. مشاهده می شود به ازای برخورد پرتو با $LET=1.2 MeV$ وضعیت منطقی خروجی ها دستخوش تغییر شده است. محاسبات مشابهی برای نقاط مختلف ترانزیستورهای NMOS و PMOS انجام شد. نتایج به دست آمده در نواحی مختلف بیانگر این واقعیت است که تغییر وضعیت منطقی خروجی ها به ازای مقدار متفاوتی از LET روی می دهد. در این محاسبات، کمترین مقدار LET که در هر نقطه منجر به تغییر در وضعیت منطقی خروجی ها می شود به عنوان معیاری از حساسیت در نظر گرفته شده است. مقایسه ای از حساسیت نقاط مختلف به پرتو در ترانزیستورهای NMOS و PMOS به ترتیب در شکل های (۱۰) و (۱۱) نشان داده شده است.

در شکل ۱۲، کمترین LET لازم جهت تغییر در وضعیت منطقی خروجی معکوس‌کننده‌ها به‌ازای طول مسیرهای مختلف پرتو فرودی نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، LET کمینه برای ایجاد یک به‌هم‌ریختگی با افزایش طول مسیر ذره درون سلول کاهش می‌یابد و کمترین مقدار آن نیز زمانی است که ذره کل مسیر داخل سلول را پیموده باشد. با این توضیح، طول مسیر ۱ μm برای پرتو فرودی، حساس‌ترین وضعیت را به‌دست می‌دهد که در مورد NMOS و PMOS یکی است. به‌بیان دیگر، حساس‌ترین وضعیت مربوط به زمانی است که ذره فرودی پس از ورود به قطعه نیمه‌هادی، عمق قطعه را پیموده و از آن خارج شده باشد. یعنی، برد ذره فرودی بیش از عمق قطعه نیمه‌هادی باشد.

حجم ناحیه حساس به پرتو در کل سلول، با جمع حساس‌ترین نواحی در ترانزیستورهای PMOS و NMOS، معادل با ۰/۰۵۴ μm³ به دست آمد. این حجم در SRAM با فناوری ۶۵ نانومتری CMOS در پژوهش Bing و همکارانش معادل با ۰/۰۵ μm³ گزارش شد [۲۰] که اختلاف ۸٪ قابل قبولی را نشان می‌دهد. شایان ذکر است که در این مرجع، نویسندگان ناحیه حساس به پرتو را بدون انجام شبیه‌سازی‌های الکترونیک و صرفاً با مدلی که به کمک کالیبراسیون با داده‌های تجربی به‌دست آمد، توصیف کرده‌اند.

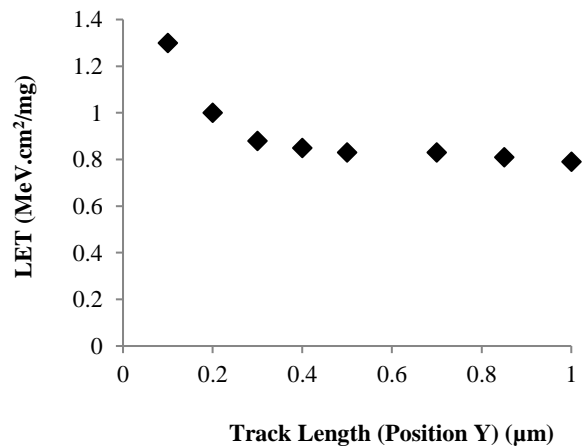
پس از تعیین ناحیه حساس به پرتو در گام بعد، به‌تعیین بار بحرانی حافظه SRAM با فناوری ۶۵ نانومتری CMOS پرداخته شد. با توجه به مرجع [۲۱]، ترانزیستورهای NMOS حساسیت بیشتری در مقایسه با ترانزیستورهای PMOS در برابر پرتو دارند. از طرف دیگر، حساس‌ترین وضعیت زمانی است که پرتو به یک ترانزیستور NMOS در حالت خاموش برخورد کند [۱۷]. با فرض برخورد پرتو به ترانزیستور M₃ از نوع NMOS در شکل ۱، این ترانزیستور به صورت سه‌بعدی مدل شد. به‌منظور ملاحظه بیشترین میزان حساسیت نسبت به پرتو، ترانزیستور M₃ در حالت خاموش یعنی با V_{GS}=0 V در نظر گرفته شد و پرتو فرودی با مقادیر متفاوتی از LET به درین ترانزیستور که ناحیه حساس‌تری در مقایسه با سایر نواحی است، برخورد کرد [۲۲] و هر بار تغییرات ولتاژ در دو نقطه Q و Q̄ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نهایی، در شکل ۱۳ نشان داده شده است. چنانچه اشاره شد، بار بحرانی، کمترین بار مورد نیاز برای تغییر حالت منطقی ولتاژ خروجی در نقاط Q و Q̄ است. بار بحرانی در لحظه‌ای که حالت منطقی ولتاژ خروجی شروع به تغییر می‌کند، با انتگرال‌گیری از جریان خروجی (جریان درین ترانزیستور M₃) مطابق با رابطه (۱) به‌دست می‌آید.

$$Q_{critical} = \int_{t_0}^{t_{critical}} I_D(t) dt \quad (1)$$



شکل ۱۱- حساس‌ترین ناحیه به پرتو در PMOS.

نتایج به‌دست آمده در شکل‌های ۱۰ و ۱۱ بیانگر این است که در NMOS و PMOS نواحی وجود دارند که به‌ازای مقادیر کمتری از LET حالت منطقی خروجی معکوس‌کننده‌ها تغییر وضعیت می‌دهد. از این رو، این نواحی حساسیت بیشتری به پرتو نسبت به سایر نواحی دارند.



شکل ۱۲- حساسیت نسبت به طول مسیرهای مختلف ذرات.

با نقشه راه ITRS برای فناوری ۶۵ نانومتر ارائه گردید. برای تعیین حجم حساس، پرتو فرودی با مقادیر گوناگون انتقال خطی انرژی (LET)، به نواحی مختلف ترانزیستورهای مذکور تابانیده شد و تغییر ایجاد شده در ولتاژ خروجی معکوس کننده ها مورد بررسی قرار گرفت. در این محاسبات، کمینه مقدار LET که در هر نقطه منجر به تغییر در وضعیت منطقی خروجی ها می شود، به عنوان معیاری از حساسیت در نواحی مختلف در نظر گرفته شد. مطابق با محاسبات انجام شده، حجم حساس $0.054 \mu\text{m}^3$ به دست آمد که با مرجع مورد بررسی که در آن حجم حساس $0.05 \mu\text{m}^3$ گزارش شده، تطابق بسیار خوبی را نشان می دهد. برای تعیین بار بحرانی نیز به کمک شبیه سازی های یاد شده، ترانزیستوری که پرتو به آن برخورد کرده، به صورت سه بعدی مدل و سایر اجزا به صورت المان های مدار در نظر گرفته شدند. سپس، پرتو فرودی با مقادیر مختلف LET به درین ترانزیستور NMOS به عنوان حساس ترین ناحیه در برابر پرتو تابانده شد و هر بار ولتاژ در خروجی معکوس کننده ها مورد بررسی قرار گرفت. بار بحرانی با انتگرال گیری از جریان درین در لحظه تغییر وضعیت منطقی ولتاژ خروجی به ازای کمترین میزان LET حاصل می شود. نتایج محاسبات، مقدار بار بحرانی را $1/48 \text{ fC}$ برای فناوری ۶۵ نانومتر نشان دادند که در توافق قابل قبولی با اندازه گیری های تجربی گزارش شده در مراجع که مقدار بار بحرانی را $1/35 \text{ fC}$ گزارش کرده اند، قرار دارد.

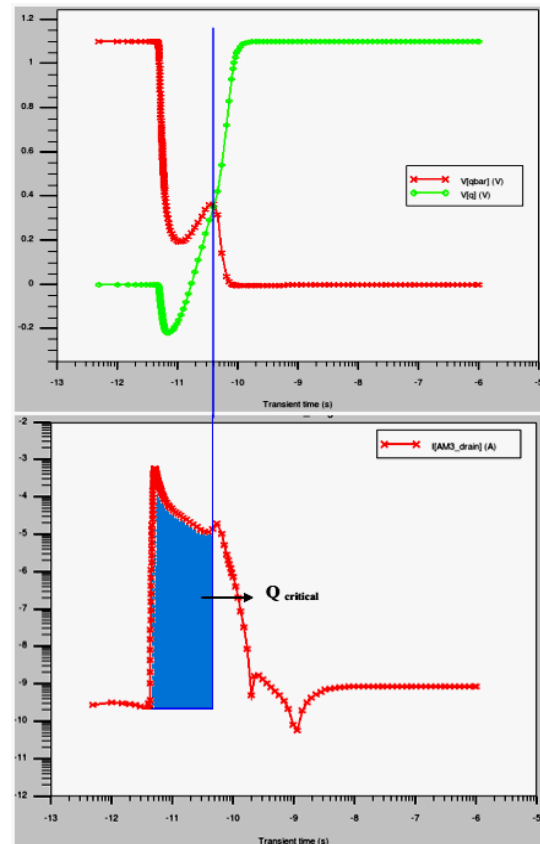
تعارض منافع

"هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است."

مراجع

- [1] G. Hubert, L. Artola, and D. Regis, "Impact of scaling on the soft error sensitivity of bulk, FDSOI and FinFET technologies due to atmospheric radiation," *Integration*, vol. 50, pp. 39-47, 2015.
- [2] P.E. Dodd, and L.W. Massengill, "Basic mechanisms and modeling of single-event upset in digital microelectronics," *IEEE Transactions on nuclear Science* Vol.50, No. 3 , pp 583-602, 2003.
- [3] C. Slayman, "Soft error trends and mitigation techniques in memory devices," *In 2011 Proceedings-Annual Reliability and Maintainability Symposium.*, pp. 1-5, IEEE 2011.
- [4] F. Wang, and D.V. Agrawal, "Single event upset: An embedded tutorial," *In 21st International Conference on VLSI Design*, pp. 429-434. IEEE, 2008.
- [5] D. F. Heidel, P. k. Rodbell, P. Oldiges, and et al. "Single-event-upset critical charge measurements and modeling of 65 nm silicon-on-insulator latches and memory cells," *IEEE Trans on nuclear science* , Vol.53, No. 6, pp. 3512-3517, 2006.
- [6] M. Zerarka, P. Austin, and M. Bafleur. "Comparative study of sensitive volume and triggering criteria of SEB in 600 V planar and trench IGBTs." *Microelectronics Reliability*, Vol. 51, No. 9-11, pp 1990-1994, 2011.

مطابق با شکل ۱۳، بار بحرانی با محاسبه مساحت زیر منحنی به صورت رنگی نشان داده شده، به دست آمده است.



شکل ۱۳- بار بحرانی با محاسبه مساحت زیر منحنی

با محاسبه مساحت ناحیه نشان داده شده در شکل ۱۳، بار بحرانی به ازای بایاس $1/1 \text{ V}$ برابر با $1/48 \text{ fC}$ به دست آمد. مقدار بار بحرانی در شرایط مشابه برای SRAM با فناوری ۶۵ نانومتری CMOS در مرجع [۲۰]، $1/35 \text{ fC}$ گزارش شده است که انطباق قابل قبولی با این پژوهش دارد. شایان ذکر است، محاسبات مشابهی نیز برای تعیین بار بحرانی PMOS انجام گرفت. نتایج محاسبات، مقدار بار بحرانی PMOS در بایاس $1/1 \text{ V}$ را $3/13 \text{ fC}$ نشان دادند. این نتیجه، بیانگر حساس تر بودن ترانزیستورهای NMOS نسبت به PMOS در برابر پرتو است که در مرجع [۲۱] نیز بدان اشاره شده بود.

نتیجه گیری

در این پژوهش، به محاسبه حجم حساس و بار بحرانی در یک حافظه SRAM با فناوری ۶۵ نانومتری CMOS پرداخته شد. بدین منظور، در ابتدا یک سلول از حافظه با استفاده از شبیه سازی های Victory و Mixed-Mode نرم افزار Silvaco TCAD شبیه سازی شد و یک مدل سه بعدی برای ترانزیستورهای NMOS و PMOS سازنده آن منطبق

- [15] B. Hoefflinger, "ITRS: The international technology roadmap for semiconductors." *In Chips 2020: a guide to the future of nanoelectronics* pp. 161-174. Springer, Berlin, Heidelberg, 2011.
- [16] I. Kumar, A. Bharth, A. K. Jaiswal, A. Kumar. "Optimization of Threshold Voltage for 65nm PMOS Transistor Using Silvaco TCAD Tools." *IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering* , Vol. 6, No. 1, pp. 62-67, 2013.
- [17] J. D. Black, D. R. Ball Ii, W. H. Robinson, and et al. "Characterizing SRAM single event upset in terms of single and multiple node charge collection." *IEEE Transactions on Nuclear Science* , Vol. 55, No. 6, pp 2943-2947, 2008.
- [18] H. Dussault, J. W. Howard, R. C. Block, M. R. Pinto, and et al. "Numerical simulation of heavy ion charge generation and collection dynamics." *IEEE transactions on nuclear science* , Vol. 40, No. 6 , pp. 1926-1934, 1993.
- [19] K. M. Warren, R. A. Weller, M. H. Mendenhall, and et al, "The contribution of nuclear reactions to heavy ion single event upset cross-section measurements in a high-density SEU hardened SRAM." *IEEE transactions on nuclear science* , Vol. 52, No. 6, pp. 2125-2131, 2005.
- [20] B. Ye, J. Liu, T.S Wang, and et al "Impact of energy straggle on proton-induced single event upset test in a 65-nm SRAM cell." *Chinese Physics B* , Vol. 26, No. 8, p. 088501, 2017.
- [21] M. Soleimaninia, G. Raisali, and A. Moslehi. "A detailed simulation study on the effect of energy and angle of incidence for low energy protons on Single Event Upsets induced in nanometer CMOS SRAM." *Journal of Instrumentation* , Vol. 16, No. 03: p. 03015, 2021.
- [22] M. Manzar, S. Hafiz, S. Khan, and et al , "Intensity Threshold Study of 6T 7T and 10T SRAM by TCAD Simulation with Optical Beam." *In International Conference on Solid State Science and Technology. ICSST*, Vol. 24, No 1, pp 210-219, 2016.
- [7]M. Zerarka , P. Austin, F. Morancho, and et al. "Analysis study of sensitive volume and triggering criteria of single-event burnout in super-junction metal-oxide semiconductor field-effect transistors." *IET Circuits, Devices & Systems* ,Vol. 8, No. 3 , pp 197-204, 2014.
- [8]M. Zerarka , P. Austin , A. Bensoussan, and. Et al. "TCAD simulation of the single event effects in normally-OFF GaN transistors after heavy ion radiation." *IEEE Transactions on Nuclear Science* , Vol. 64, No. 8 , pp 2242-2249, 2017.
- [9] R. Naseer , Y. Boulghassoul, J. Draper, and et al. "Critical charge characterization for soft error rate modeling in 90nm SRAM." *In 2007 IEEE International Symposium on Circuits and Systems*, pp. 1879-1882. IEEE, 2007.
- [10] E. Farjallah, V. Gherman, J-M. Armani, and L. Dilillo. "Evaluation of the temperature influence on SEU vulnerability of DICE and 6T-SRAM cells." *In 2018 13th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems In Nanoscale Era (DTIS)*, pp. 1-5. IEEE, 2018.
- [11] R. Rajaei, B. Asgari, M.Tabandeh, and M. Fazeli. "Design of robust SRAM cells against single-event multiple effects for nanometer technologies." *IEEE Transactions on Device and Materials Reliability* , Vol.15, No. 3 , pp.429-436 , 2015.
- [12] Victory Device User's Manual, Silvaco, Inc. 4701 Patrick Henry Drive, Bldg. 2 Santa Clara, CA 95054, (408) 567-1000, <http://www.silvaco.com>, January 26, 2015.
- [13] M. Sajid, N. G. Chechenin, F. S. Torres, and, et al., "Single Event Upset rate determination for 65 nm SRAM bit-cell in LEO radiation environments," *Microelectronics Reliability*, Vol. 78, pp. 11-16, 2017.
- [14] P. KUMAR, M. Vashishath, P.K. bANSAL. "An Investigation into NMOS at 65 nm using Silvaco TCAD," *International Journal of Management, Technology and Engineering*, Vol. 8, 2018.